



1) powierzchnia aktywna, 2) Strefa wolna, 3) patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA WEEE
EN 55011	Wlk.1,kl.A
EN 55022	Gr.1,Kl.B
Kształt anteny	okrągły
Zasada działania	Nośnik danych

Electrical data

Cykle odczytu	bez ograniczeń
Cykle programowania	≥ 100.000
Czas odczytu	do 4 bajtów: 0.18 s
Czas programowania	do 4 bajtów: 0.305s
Czas przechowywania danych / lata	≥ 10
Organizacja pamięci	48 × 4 bits

Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony	IP68, 1 m, 24 h, 20 °C
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Temperatura składowania, tymczasowa	-40...130 °C 1x1000 h

Functional Characteristics

Numer seryjny UID, tylko do odczytu	5 Byte
Typ pamięci	EEPROM

Material

Materiał obudowy	PPS, EP
------------------	---------

Mechanical data

Masa	0.80 g
Montaż	bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Wymiary	Ø 12,4 x 2 mm

LF (125 kHz)
BIS L-103-05/L-RO
Kod artykułu: BIS003F

BALLUFF

Remarks

Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.

Nośnik danych zaprogramowany wg życzeń klienta. Warunki użytkowania tylko w połączeniu z systemem odczytu L-4xx. Oznaczenie danych klienta lub danych programowania odbywa się wyłącznie na opakowaniu, NIE na nośniku danych. Po dostarczeniu klient jest sam odpowiedzialny za dokumentację danych programowania.

Tylko w połączeniu z przewidzianą głowicą zapisu/odczytu.

Warunki zastosowania patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu.

Informacja o czasie w tym kontrola danych.

Obciążenia skrętne, zginające i udarowe są niedopuszczalne.

Przy montażu w metalu: pamiętać o strefie wolnej.